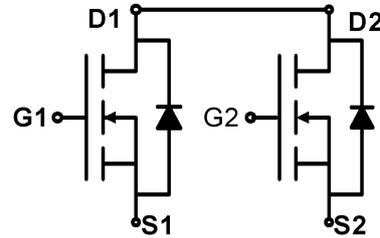


12V, 6A, N 型 MOSFET

1. 描述

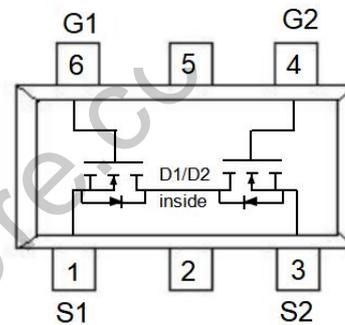
- ◆ 12V MOSFET 技术
- ◆ 极低的导通电阻
- ◆ 超快的开关速度
- ◆ Drain(2、5脚内部连接金属线连接)



电路结构图

2. 应用

- ◆ 用于单节锂电池保护（仅限于锂电池保护板使用）



顶视图

(D1/D2 Pin2 和 Pin5 不连出)

3. 出货信息

工作温度范围 (结温)	封装		订购型号	印章	包装数量
-55°C ~ +150°C	SOT23-6	Pb-Free	NP8810N	.8810N	3000 片/盘

备注：（2、5 脚内部金属线连接）。

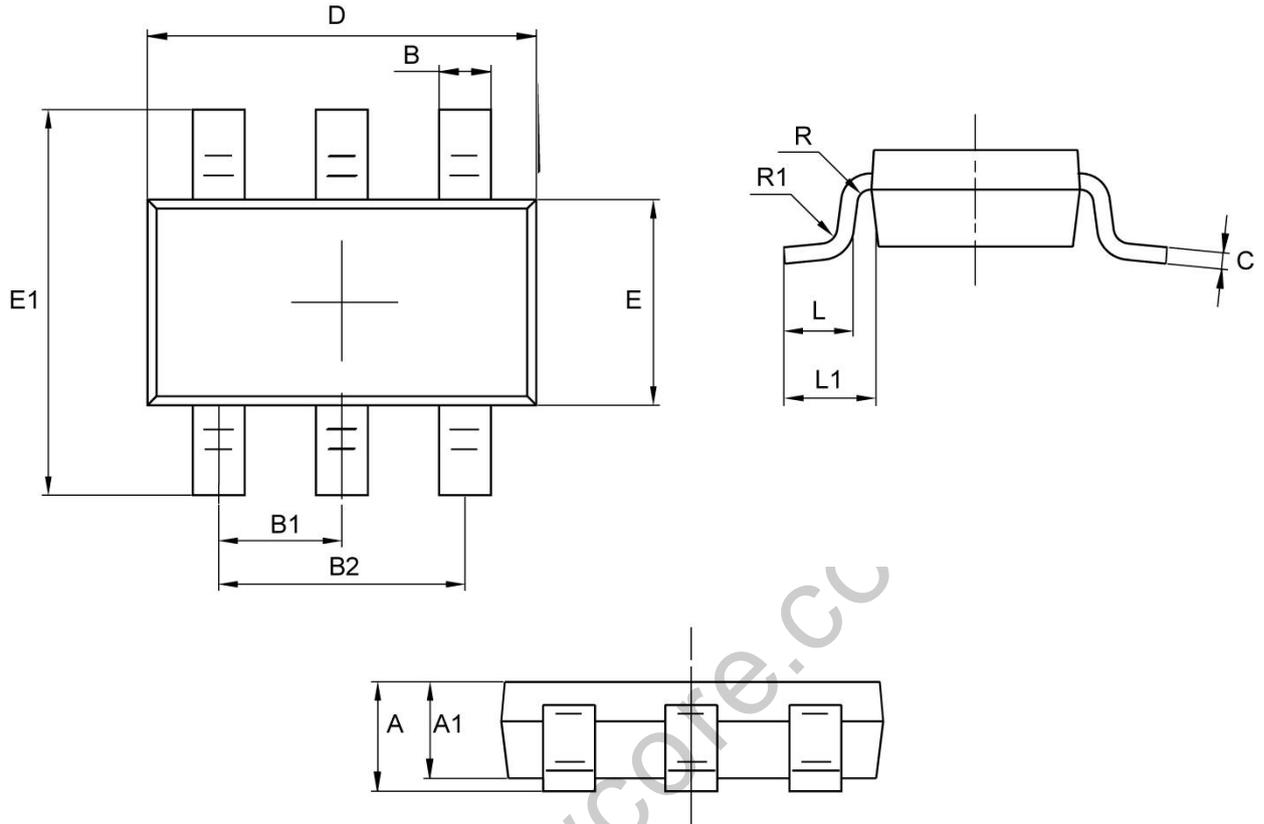
4. 最大额定参数

参数	符号	值	单位
漏源电压	V_{DS}	12	V
栅源电压	V_{GS}	± 10	V
漏极电流, $V_{GS} = 4.5V, @T_a = 25^\circ C$	I_D	6	A
漏极电流, $V_{GS} = 4.5V, @T_a = 70^\circ C$	I_D	4.8	A
漏极脉冲电流	I_{DM}	20	A
工作结温	T_j	-55 ~ +150	$^\circ C$
存储温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ C$

5. 电气特性 ($T_j = 25^\circ C$, 除非另有注明)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS} = 0, I_D = 250\mu A$	12	16		V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0$	-	-	1	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 10V, V_{DS} = 0$	-	-	± 1	μA
击穿电压温度系数	$\frac{\Delta BV_{DSS}}{\Delta T_j}$	参考点 $25^\circ C$ $I_D = 1mA$	-	0.03	-	$V/^\circ C$
栅极门限电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$	0.4	0.65	1.0	V
漏源导通电阻 (双MOS)	$R_{SS(ON)}$	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 6A$	-	26	32	$m\Omega$
		$V_{GS} = 3.8V, I_D = 3A$	-	30	40	$m\Omega$
		$V_{GS} = 2.5V, I_D = 3.0A$	-	37	50	$m\Omega$
正向跨导	g_{fs}	$V_{DS} = 5V, I_D = 4.5A$	-	10	-	S
源漏正向导通电压	V_{SD}	$I_S = 1.0A, V_{GS} = 0V$ $T_j = 25^\circ C$	-	0.72	1.2	V

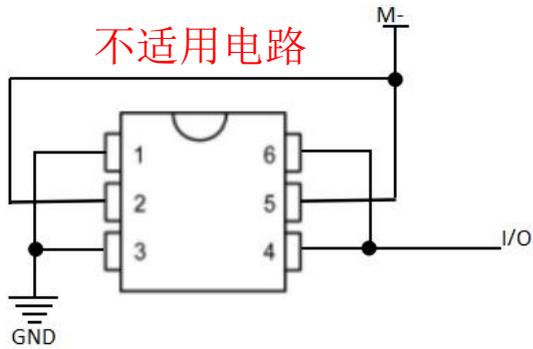
6.封装尺寸(SOT23-6)



符号	尺寸 (mm)		符号	尺寸 (mm)	
	最小值	最大值		最小值	最大值
A		1.450	B2	1.900	
A1	0.900	0.130	C	0.127	
D	2.900		L	0.600	
E1	2.800		L1	0.250	
E	1.600		R	0.100	
B	0.300	0.500	R1	0.100	0.250
B1	0.950				

7. 注意

不适用电路如下！不可当10mohm MOSFET并联使用



声明

这里给出的一些信息是在某些特殊封装下的特性，不作为保证内容。

我们保留对交货条款和技术更新的权利。

我们拒绝任何形式的担保，包括但不限于对在此陈述的电路、描述和表格的非侵权保证。